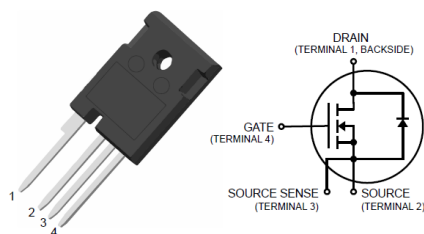


## SiC MOSFET(3300V) : Microchip Technology MSC080SMA330B4N 概要、構造、電気特性評価レポート(企画)



データシート画像より抜粋

### レポート概要

Microchip Technology が展開する 3300V耐圧 SiC MOSFET 「mSiC™」は、高耐圧・高信頼性が求められる鉄道、送配電、産業用インバータ、再生可能エネルギー分野向けデバイスとして注目されています。エルテックでも、各社の3300Vや2300Vの高耐圧 SiC MOSFETに注目して解析を行っており、今回は、同社の3300V SiC MOSFETの概要、構造解析を行い、その特徴を明らかにするとともに、中国AST TechnologyやNoMIS Powerのディスクリート製品との比較も行うレポートを企画しています。

#### 販売中レポート：3300V系デバイス

・ Infineon製 FF4000UXTR33T2M1

・ GeneSiC Semiconductor製：G2R50MT33K

#### 企画レポート：3300V系デバイス

・ MICROCHIP製：MSC400SMA330B4N

・ Shenzhen AST Technology ASC80N3300MT4

#### 販売中レポート：2300V系デバイス

・ Wolfspeed CAB6R0A23GM4T

### 製品特徴

型番：MSC080SMA330B4N Vds= 3300V, Id=43A, Ron=85mΩ 製品リリース日：2025年4月

#### 製品情報：MSC080SMA330B4N

- ・ 同社の、「mSiC™」ブランド
- ・ アプリケーション：太陽光発電インバータ、産業用モータ駆動、EV充電、スマートグリッド

### 解析内容&レポート価格

- ① 概要解析レポート： 予定価格 ¥330,000 (税別) 納期：企画成立後 2ヶ月
  - ・ パッケージ観察、チップ観察
  - ・ SiC MOSFET断面解析：セル部、チップ終端部 (SEM)
- ② 構造解析レポート： 予定価格 ¥750,000 (税別) 納期：企画成立後 2ヶ月
  - ・ ①概要解析レポートの内容を含む
  - ・ パッケージ断面解析
  - ・ 平面解析：配線接続、レイアウト確認
  - ・ 他社製品との比較
- ③ 電気特性評価レポート： 予定価格 ¥250,000 (税別) 納期：企画成立後 2ヶ月
  - ・ I-V特性 (オン特性、BVdss測定、静電容量 (最大3000V))